

2SC2881A (3DG2881A)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于一般功率放大。

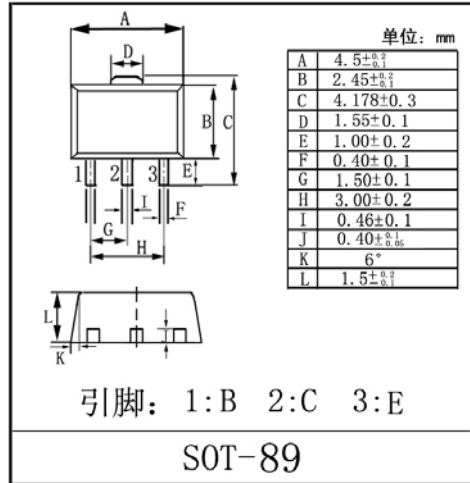
Purpose: power amplifier applications.

特点: 特征频率高, 电压高, 封装小, 与 2SA1201A (3CG1201A) 互补。

Features: High f_T , high V_{CE0} , small flat package, complementary pair with 2SA1201A (3CG1201A).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	250	V
V_{CE0}	250	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	800	mA
I_B	160	mA
P_C	500	mW
P_C^*	1.0	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



*:Mounted on ceramic substrate (250mm²×0.8t)

*装于 250mm²×0.8t 的陶瓷上。

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CE0}	$I_C=10\text{mA}$	$I_B=0$	250			V
V_{EB0}	$I_C=1.0\text{mA}$	$I_C=0$	5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=250\text{V}$	$I_E=0$			0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=5.0\text{V}$	$I_C=0$			0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_C=100\text{mA}$	80		240	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}$	$I_B=50\text{mA}$			1.0	V
V_{BE}	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_C=500\text{mA}$			1.0	V
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_C=100\text{mA}$		120		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$	$I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$			30	pF

h_{FE} 分档、印章标记/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	0	Y
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	80~160	120~240
印章 Marking	HCO	HCY

